



アニュアルレポート 2000

2000年3月期

日本語訳版

IT Revolution

Breakthrough Technology

New Materials

Shrinkage

$$S = \iiint \int (\text{Low-k}) d\epsilon_n d\rho dI dE$$

300mm Wafers

IT Revolution

Breakthrough Technology

300mm Wafers

New Mega Trends Drive SPE Demand

Breakthrough Technology

Shrinkage

New Mega Trends Drive SPE Demand

IT Revolution

300mm Wafers

New Materials

東京エレクトロンは、1963年の設立以来、半導体製造装置の世界のリーディングサプライヤーとして、酸化/拡散・LP-CVD装置、メタルCVD装置、PVD装置、コータ/デベロッパ、SODコータ、エッチング装置、洗浄装置、ウェーハプロ・バ、ウェーハレベル・バ・ンイン&テスト装置など、幅広い製品分野の開発・製造・販売を行っています。

また、半導体製造装置の分野で蓄積した専門技術を生かして、TFT-LCD製造用のコータ/デベロッパやエッチング/アッシング装置の開発・製造・販売も行っています。これらの半導体製造装置およびTFT-LCD製造装置の多くは、それぞれの世界市場でトップシェアを獲得しています。

さらに、内外の優れた半導体製造装置やコンピュータ・システム、電子部品などを日本国内で販売する専門商社としても確固たる地位を築いています。

東京エレクトロンは、アメリカ、ヨーロッパ、アジア13カ国に広がるグローバル拠点網を通じ、優れた製品とサービスをお客様に提供するとともに、株主価値の最大化に取り組んでいます。

目 次

- 1 財務ハイライト
- 2 株主の皆様へ
- 6 東京エレクトロンの事業概要
- 8 特集
- 14 環境保全
- 16 営業の概況
- 19 財務報告
- 33 取締役、監査役及び業務執行責任者
- 34 グローバルネットワーク
- 36 株主メモ

見通しに関して

本レポートにはさまざまな予測や見通しが含まれています。東京エレクトロンが事業活動を行っている市場は、激しい競争環境や速い技術革新などの特性を持ち、需給バランスの影響を受けやすい産業分野です。従いまして、本レポートで述べられている予測や見通しにはリスクや不確実性が含まれていることをご承知おきください。

財務ハイライト

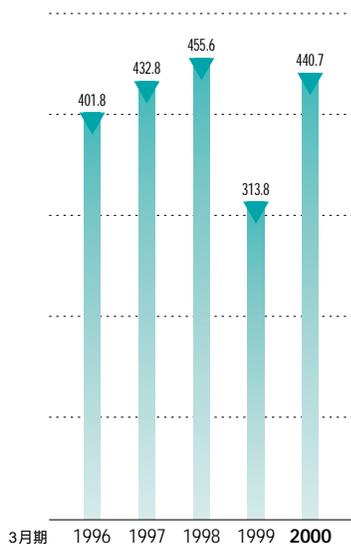
東京エレクトロン株式会社及び連結子会社
1998年3月期、1999年3月期及び2000年3月期

	百万円(注1)			千米ドル(注1)
	2000年	1999年	1998年	2000年
売上高	¥440,729	¥313,820	¥455,585	\$4,151,945
営業利益	35,816	6,383	63,296	337,409
税金等調整前当期純利益	29,689	6,038	62,834	279,689
当期純利益	19,848	1,866	30,009	186,981
1株当たり当期純利益(注2):				
1株当たり当期純利益	¥ 113.53	¥ 10.70	¥ 174.68	\$ 1.07
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	110.64	10.70	168.43	1.04
1株当たり配当金	14.00	12.00	30.00	0.13
総資産	¥499,499	¥414,903	¥493,600	\$4,705,596
純資産額	273,603	257,716	261,009	2,577,513

- 注: 1. 米ドル表示は、円金額を期末日レートである1ドル=106.15円で換算したものであります。
1株当たりの数値については、円単位並びにドル単位で表示しております。
2. 1株当たり当期純利益は期中平均株式数に基づき計算しております。
3. 1999年3月期は希薄化による影響はありません。

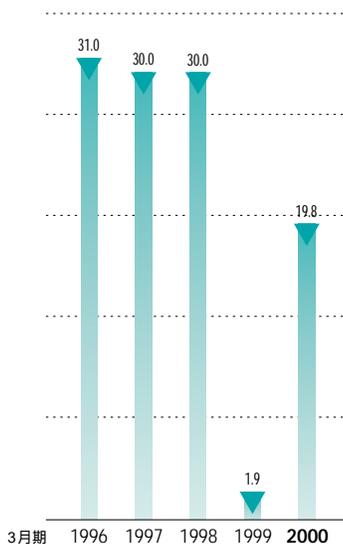
売上高 (10億円)

半導体メーカーの設備投資の世界的な回復を受け、売上高が飛躍的に増加しました。



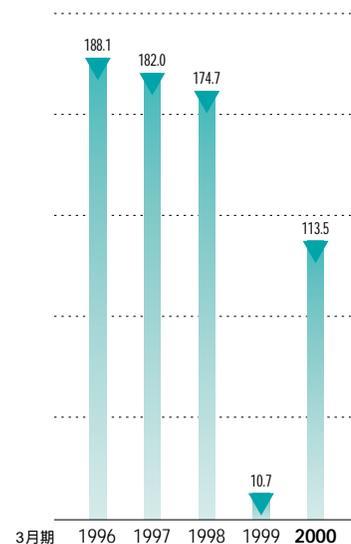
当期純利益 (10億円)

当期純利益は売上高の伸びとコスト削減を反映し198億円に増加しました。



1株当たり当期純利益 (円)

東京エレクトロンは、収益の向上を通して株主満足を継続的に追求してまいります。



株主の皆様へ



2000年3月期は、東京エレクトロンにとりまして、新しいミレニアムの幕開けにふさわしい明るいニュースに満ちあふれた年となりました。インターネットや携帯電話などの普及により加速される情報・通信革命がいよいよ本格化してきたこと、また、今や世界経済の安定に大きな役割を担うアジア経済が復興したことが大きな要因となり、私たちの参画する半導体・LCD産業がここしばらくの調整局面を脱し上昇へと転じた、まさに転換期とも言うべき年となりました。

このような状況のもと、東京エレクトロンの業績も力強い回復に転じ、当期の連結売上高は前年比40.4%増の4,407億円を達成することができました。また、連結営業利益は前期の64億円から358億円へ、当期純利益は19億円から198億円の大幅増となり、これにより一株当たり当期純利益は113.5円となりました。年間配当につきましては、当初計画を修正し2円増配の14円といたしました。

とりわけ、半導体製造装置部門の売上高は、下半期のめざましい回復により、前期比46.6%増の3,551億円となりました。また、半導体製造装置部門の受注高は第3、第4四半期と連続して過去最高を更新し、連結受注残2,653億円にて次期に引き継ぎました。東京エレクトロンの優れた製品、信頼の高いサービスサポート力、グローバルオペレーション、そして需要の急回復に敏速に対応した生産体制により、事業環境の好転をフルに享受できたものと考えます。

継続的で充実した研究開発投資が市場でのポジションを高める。今後も重点的なコアコンピタンス戦略を継続する

グローバル化が破壊的なスピードで進み、企業同士の競争が激化する時代を迎えています。こうした中で、半導体製造装置・LCD製造装置の開発レベルは年々高度化し、また開発サイクルが必然的に短縮され、それに対応できる企業のみが生き残れる様相を呈しています。東京エレクトロンは次世代以降の製品およびプロセス開発こそ、メガコンペティションに打ち勝つための生命線と捉え、市場でのポジションをさらに高めるための開発戦略の充実を継続的に図っています。

また、今、時代は装置サプライヤーに対し、開発・製造・販売・サービスに至る総合的な技術サポートと、お客様のプロセスモジュールに対して最適なソリューションを提供する統合技術を求めています。一昨年、これら垂直的・横断的統合技術をお客様とともに厳しく追求する拠点として開設した、当社の300ミリウェーハ用装置対応のプロセステクノロジーセンターは、その規模・目的・能力において現在世界が最も注目する技術拠点の一つになっています。また、一貫したプロセス処理のできる新高速熱処理炉やウェーハレベル・バーンイン&テスト装置もこのようなニーズから生まれた最新テクノロジーの成果です。

東京エレクトロンのプロダクト戦略の根幹にあるのは、高い成長が期待でき、参入障壁が高く、かつ、テクノロジー・リーダーシップを長期的に維持し得るマーケットを狙うというポリシーです。すなわち、真に東京エレクトロンの固有技術が活かされ、東京エレクトロンであるがゆえに提供できる最高度の付加価値を追求する。このアプローチを貫くことで、私たちは常に参入分野においてリーディングポジションを維持してまいりました。今後も強い競争力を持つ固有のコアプロダクトを中心に、業界他社とのアライアンスも視野に入れた統合技術の提供を実現してまいります。

当期、東京エレクトロンは、研究開発費として371億円を投じました。これは半導体製造装置部門売上高の約10%にあたり、7つの製品の新しいバージョン、300ミリ装置、さらに新規分野への開発に効率よく投じられました。この投資が実を結ぶ2～3年後には、全プロダクトに占める新製品の割合は4割以上になることが期待できます。私たちは堅固な財務基盤のもと、今後もグローバルな開発競争を有利に勝ち抜いてまいります。

新時代の配線工程のビジネスを有利に進める - 東京エレクトロンが提供するベストプロセスソリューション Low-k ツールセット

半導体チップがさらに高度な性能を発揮するためには、微細化、高速化、低消費電力化という3つの技術的課題の解決が求められています。微細化の面では、今年2000年、いよいよ線幅0.13 μ mの評価が始まり、高速化、低消費電力化の解決策として配線工程において新しい材料、銅(Cu)および低誘電率(Low-k)材の採用が今後本格化してまいります。

この度、東京エレクトロンは、次世代以降の配線工程ビジネスに大きなインパクトのある画期的なツールセットを発表いたしました。Low-k膜を配線層間にスピン塗布する CLEAN TRACK ACT[®] 8 SODと複数のコアプロダクトが実現する統合ソリューションです。今、大手半導体メーカーにおいて0.13 μ m以降における“スピン塗布”によるLow-k成膜技術の優位性が証明されつつあり、私たちの事業展望に新たな視界が広がりました。配線周りのキープロセスを早期に確立することで、高いポテンシャルのある新世代のビジネスを業界に先駆けて進展させることができるものと期待しております。

なお、個々のお客様の個々のデバイス戦略の成功こそ、東京エレクトロンが真に実現してゆくものです。その視点から、私たちは複数の材料メーカーとの共同開発を進めており、お客様が選択されるあらゆる材質のLow-k膜に対応してゆく所存です。

変革へのチャレンジ - ITの利用で収益構造を改革する

将来に向けたプロダクト戦略の充実とともに、東京エレクトロンが達成すべき課題の一つとして取り組んでいるのが、市場環境の変化に柔軟に対応するための筋肉質の事業構造の構築です。現在、当社製品への需要は上昇の一途をたどり、生産の拡大が何よりも急務となっておりますが、このような拡大基調の中にありながらも、資産効率を高め、収益を最大化できるIT時代の幕開けに相応しい新たなしくみ作りにもチャレンジをいたします。

その取り組みの一つが、受注から出荷までのリードタイムのドラスティックな短縮を重点課題に置く「トータル・コストダウン・プロジェクト」です。当期の成果として、生産形態の徹底的な見直しの結果、当社の製造のあるべき姿が見出され計画の全体像が策定されました。今後は、製造フロー自体の改革にIT統合ツールによるソリューションを加えることにより、2~3年内を目途にリードタイム半減という高い目標に向かって引き続き邁進してゆくこととなります。なお、リードタイムの短縮がもたらす最大の成果が、市場のニーズに応えること、つまり「顧客満足」であることは申し上げるまでもありません。

また、最も価値ある資産、ヒューマンリソースの活用についても、間接部門の効率化プロジェクトがスタートいたしました。人間が「知恵」を生み出す主体となり、創造的価値の創出が可能になる体制を中期的に構築することを目指します。ここにおいてもIT戦略の推進が鍵となります。外部のリソースの積極活用を含めて、構造のスリム化を実現するための具体策を引き続き実行してまいります。

株主の視点に立った経営をさらに進める

東京エレクトロンは、日本の株式市場に公開している企業としては、いち早く、世界に通用するコーポレート・ガバナンスの理念を積極的に取り入れてきた企業の一つです。取締役会の改革をはじめ、ストックオプション/業績連動型インセンティブプランの導入、代表取締役報酬の公表など、近年、企業価値のさらなる最大化を図り、経営の透明性を高めるための様々な改革を迅速に行ってまいりました。

2001年3月期、新たな進展として、当社のストックオプションをグループワイド、グローバルワイドに広げます。日本の現行の商法はストックオプションの適用範囲を親会社に限定していますが、ワラント債を利用した疑似ストックオプションを導入すること、さらに産業活力再生特別措置法が適用されることでこれを実現いたします。特に、国際レベルで展開する優れた人材の採用において、当制度がもたらす効果に大いに期待をいたしております。

また、ROEの向上を具体的に実現するために、事業部門ごとに正味使用資産を分母にとったROAの目標値を定め、その達成度にて経営評価を行うしくみを

作りました。現場レベルに資産の有効活用とコントロールを通して株主価値の向上を意識付ける有効な方法になると捉えています。これにより、できるだけ早期にROE20%以上の達成を目指してまいります。

さらに、グローバル資本市場からの信頼をより高めるために連結ベースの四半期決算の開示を始めます。

世紀的なイノベーション、IT革命が東京エレクトロンへの追い風となる

今、私たちは、世紀的なイノベーションと言われる情報・通信革命のただ中にいます。インターネットや携帯電話が生活シーンに浸透し、自動車のように身近なものになる時代、また、e-ビジネスが広く普及し、20世紀に確立された産業地図が塗り替わる時代の始まりとも言えます。さらに、デジタル情報家電をはじめとする新しい製品が続々と登場し、半導体チップやLCDの用途も量も今後爆発的に拡大してゆきます。これらのIT革命のキー・デバイスを作るためにいったいどれだけの半導体製造装置およびLCD製造装置が必要になるのか、それを考えるとき、東京エレクトロンのさらなる事業拡大の可能性の大きさが推測されると思います。

また、東京エレクトロンのもう一つの顔となっている世界の優れた電子部品、コンピュータ・ネットワーク製品のディストリビューションにおいても、情報・通信分野のアプリケーションに的を絞っており、今後さらなる成長が期待できます。私たちは今後も優れた製品とサービスの提供を通して、IT革命を根底から支えてまいります。

2000年4月、日経平均株価を構成する銘柄の入れ替えが行なわれ、新たに東京エレクトロンの株式が225社の1社として栄誉ある選定を受けました。IT革命の進展など産業構造の変化に拍車がかかる中、時代の動向を敏感に映す株式会社であることを理由に組み入れられたものです。また、来たる8月1日、多くの方々に当社株式を保有していただける機会を提供するために、当社の1単位の株式数を1,000株から100株に引き下げる予定です。

東京エレクトロンは、新しい時代のダイナミズムを追い風に、企業価値の創造を通して株主の皆様をはじめとするあらゆるステークホルダーへの利益還元を継続的に実現してまいります。株主の皆様には、今後ともご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

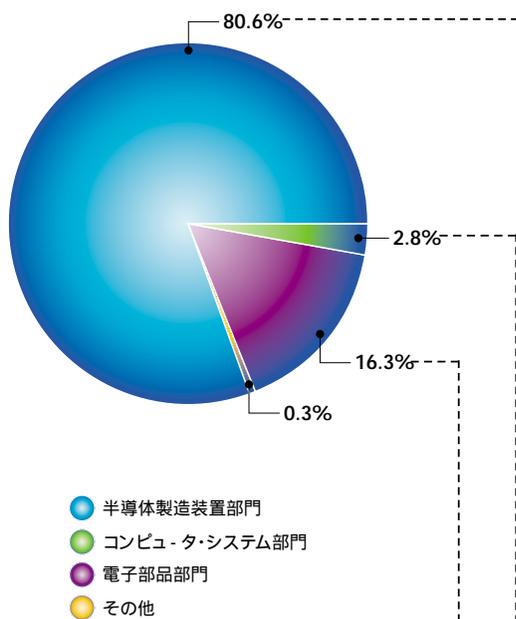
2000年6月



代表取締役社長
東 哲郎

東京エレクトロンの事業概要

部門別売上構成比 (2000年3月期)



半導体製造装置

当部門では、自社開発の最先端の半導体製造装置を幅広くとり揃えるとともに、他社の優れた製品も提供しています。

自社開発製品

- 酸化/拡散・LP-CVD装置
- メタルCVD装置
- PVD装置
- コータ/デベロッパ
- SODコータ
- エッチング装置
- キャリアレス洗浄装置
- スクラパー
- 全自動ウェーハブローバ
- ウェーハレベル・パニンイン&テスト装置



酸化 / 拡散・LP-CVD装置
TEL - ATP/ATPf - 300

LCD製造装置

半導体製造装置事業で蓄積された技術は、LCD製造装置の開発・製造に生かされ、強力な製品ラインアップを作り上げています。

コンピュータ・システム

当部門では、世界のトップサプライヤーのコンピュータ及びネットワーキング関連製品を国内で販売し、ユーザーに最適なソリューションを提供しています。

- コンピュータ・システム
- ネットワーキング製品
- データマネジメントソフトウェア
- ボードテストシステム

電子部品

当部門では、世界のトップクラスの選りすぐられた電子部品を幅広くとり揃えています。さらに、柔軟な技術サポートにより、個々のユーザーニーズに対応した総合的なソリューションを提供しています。

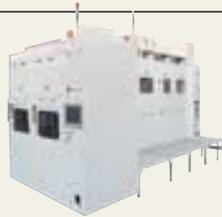
- 半導体デバイス
- ボード
- コンポーネント
- ソフトウェア



メタルCVD装置
UNITY®-EP



エッチング装置
UNITY® Ver. IIe



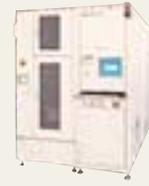
キャリアレス洗浄装置
UW200Z



コータ/デベロッパ
CLEAN TRACK ACT®12



全自動ウェーハプロバ
P-12XL



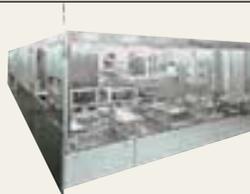
ウェーハレベル・バーンイン&テスト装置
WX-8

輸入販売製品

FEI Company
FIB systems
Rudolph Technologies, Inc.
Film metrology tools
ISOA, Inc.
Macro Inspection System
Yield Dynamics, Inc.
Yield Management Software

自社開発製品

LCDコータ/デベロッパ
LCDプラズマエッチング/アッシング装置



LCDコータ/デベロッパ
CS800



LCDプラズマエッチング/アッシング装置
HT-800



Hewlett-Packard Co.
HP Visualize Workstation



Extreme Networks, Inc.
Gigabit ETHERNET Switch

Brocade Communications Systems, Inc.
Ciprico, Inc.
Conax Florida Corp.
Cycomm International, Inc.
Emulex Corporation
Extreme Networks, Inc.
F5 Networks, Inc.
Gadzoom Networks, Inc.
GenRad, Inc.
Genroco, Inc.
H. Koch & Sons Co.

Hewlett-Packard Co.
(株)日立制作所
Interstate Electronics Corp.
ITT Aerospace Controls Corp.
Marconi Communications, Inc.
nCIPHER Corporation Ltd.
(株)エヌ・ティ・ティ・エックス
OEA Aerospace, Inc.
Pathlight Technology, Inc.
Prisa Networks, Inc.
Process Dynamics, Inc.

Sanders, a Lockheed Martin Co.
Silicon Graphics, Inc.
ソニー(株)
VERITAS Software Corp.



半導体デバイス



ボード

Advanced Micro Devices, Inc.
Agilent Technologies, Inc.
Conexant Systems, Inc.
コーセル(株)
Dallas Semiconductor Corp.
Dialogic Corp. (an Intel Company)
(株)デジタル
Eicon Technology Corp.
(Trisignal Div.)
富士フィルムマイクロデバイス(株)
富士通(株)
富士通量子デバイス(株)
富士通メディアデバイス(株)

Integrated Device Technology, Inc.
Intersil Corp.
Intoto Inc.
Linear Technology Corp.
Metrowerks, Inc.
Microsoft Corp.
Mitel Corp.
Motion Engineering, Inc.
Motorola, Inc.
ON Semiconductor
Phoenix Technologies Ltd.
Pixelworks, Inc.
Portwell, Inc.

Ramtron International Corp.
Robinson Nugent, Inc.
シャープセミコンダクタ(株)
Siber Core Technologies Inc.
東京エレクトロデバイス(株)
Trillium Digital Systems, Inc.
Tundra Semiconductor Corp.
VenturCom, Inc.
WESTTEK, L. L. C.
Winchester Electronics
Xicor, Inc.
Xilinx, Inc.

半導体製造装置 - イノベーションの

絶え間ない半導体の進化が、情報・通信革命(IT革命)を牽引しています。しかしながら、製造装置の世界マーケットリーダー、東京エレクトロンは、世界の半導体メーカーが



半導体のアプリケーションが広がり、産業の成長が加速する

これまで、パーソナルコンピュータが半導体の市場拡大を牽引する主役でした。しかし、今や、コンピュータだけでなく、携帯電話、PDA、ゲーム機、DVDプレーヤーをはじめとする多くのデジタル製品に高性能、高機能の半導体が搭載されるようになり、産業の成長が加速されています。そして、私たちの想像を超える半導体のアプリケーションが今後続々と登場し、半導体需要はさらに拡大してゆくことでしょう。

ウェーハプロセス装置のマーケットリーダー、東京エレクトロン

ウェーハプロセス装置は、シリコンでできたウェーハと呼ばれる円形の基板に、主に化学反応や物理反応を利用して、極めて微細でしかも複数の層からなる回路を作り込むための高度なプロセスツールです。このマイクロの世界をつかさどる様々な種類のウェーハプロセス装置も、大きくいくつかのグループに分けることができます。世界の多くの装置メーカーが主に単一プロダクトを提供する中、東京エレクトロンはマルチプロダクトサプライヤーとして幅広い製品群をとり揃え、それぞれの装置分野で世界のマーケットリーダーとなっています。

ウェーハ プロセス装置

■ 熱処理装置

■ 不純物注入装置

■ 薄膜形成装置

■ 露光/回路形成装置

■ 表面処理装置

始まりはここから

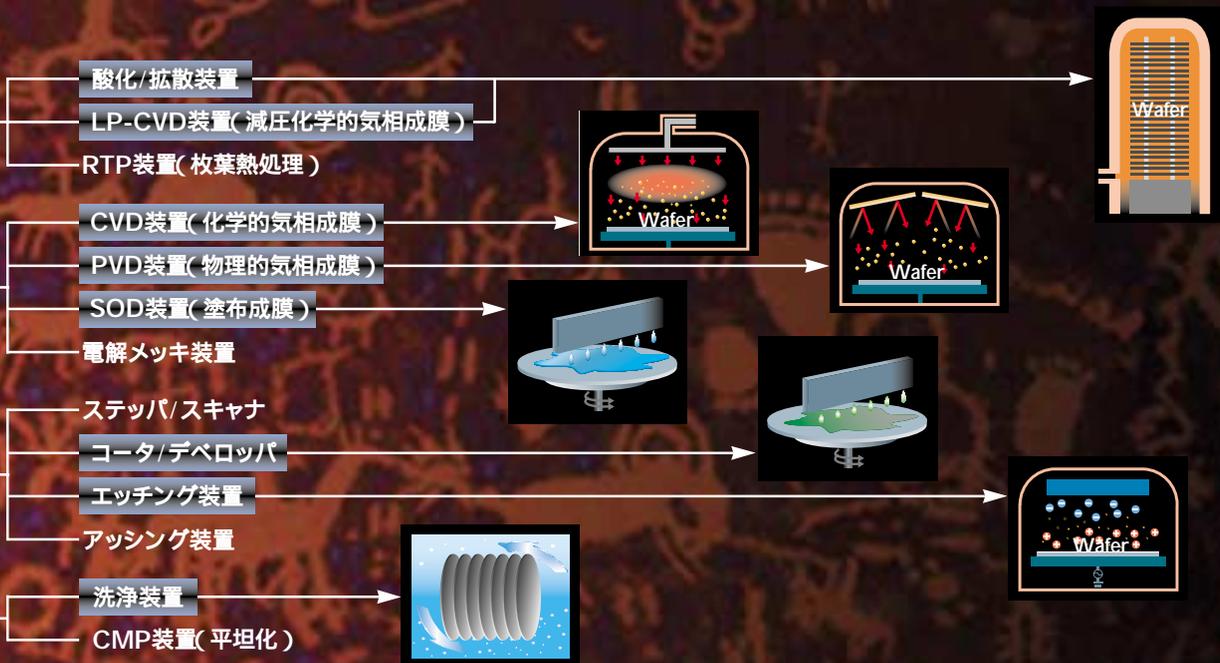
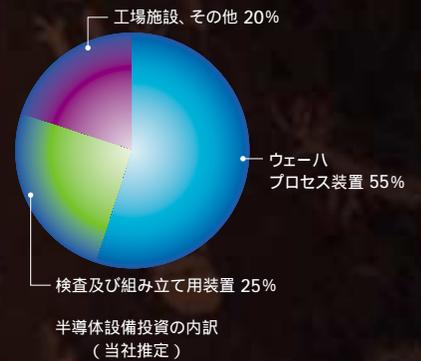
その半導体を作る半導体製造装置の進化なくして、今日のIT革命はありえません。半導体優れた半導体を作り出す基盤を提供し、このIT革命の進展に大きな貢献を果たしています。

半導体製造装置 半導体産業の発展を支えるツール

半導体製造装置産業はエレクトロニクス産業、そしてさらに、エレクトロニクス産業を支える半導体産業にとって、極めて重要な役割を果たす産業です。情報・通信関連製品の頭脳は高性能半導体であり、この優れた頭脳は、優れたツール、半導体製造装置なくしてこの世に生み出されることはありません。つまり、これからますます進展するであろう情報通信革命を根底から支えるのは半導体製造装置の進化とも言えるのです。

半導体関連設備投資の多くを占めるウェーハプロセス装置

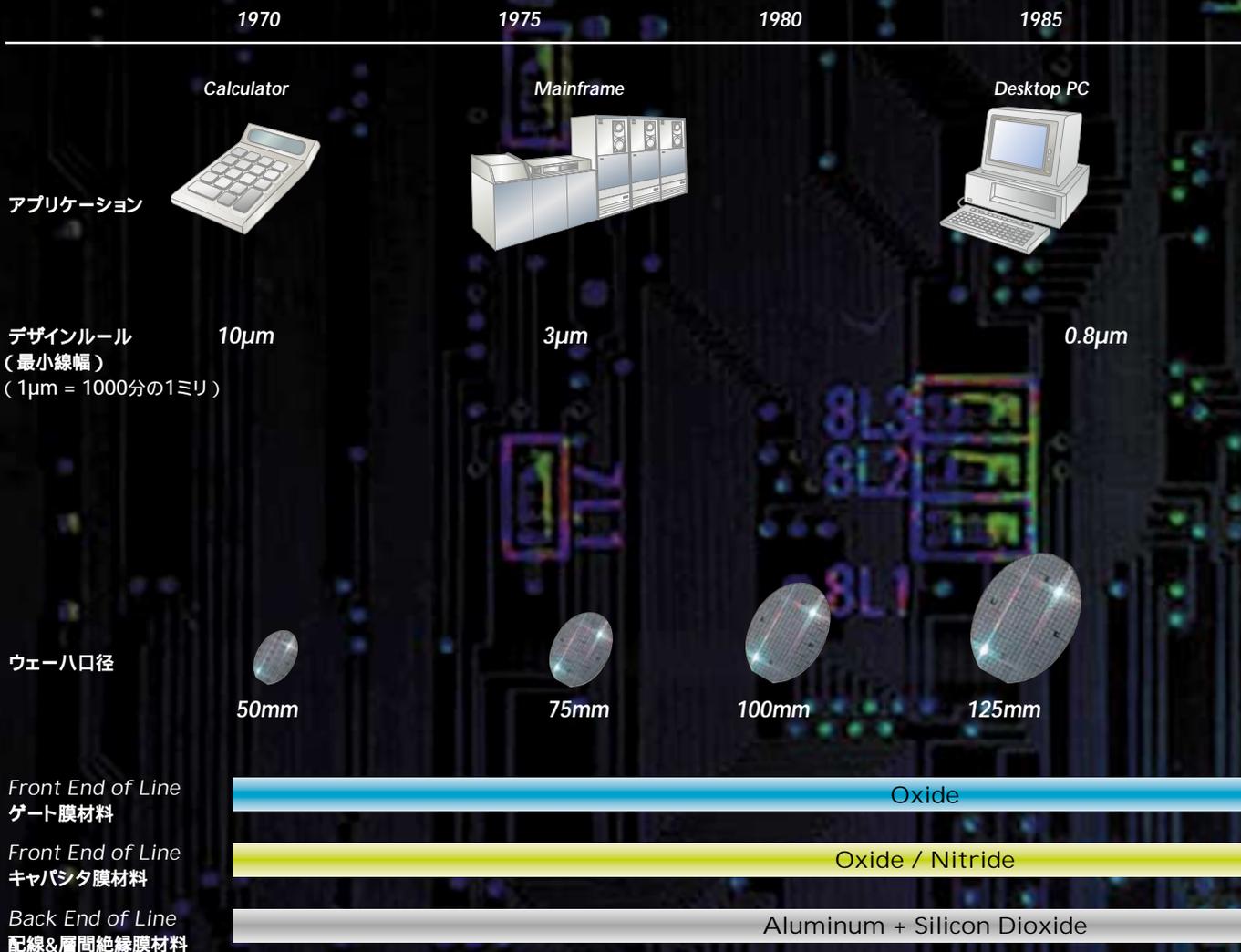
半導体製造装置は、半導体製造工程の前半部分で使われるウェーハプロセス装置と、後半部分で使われる検査及び組み立て装置に大きく分けられます。1999年、ウェーハプロセス装置に対する半導体メーカーの投資額は、半導体関連設備投資全体額330億ドルの約55%に至りました。東京エレクトロンが提供する装置の多くも、このウェーハプロセス装置です。製品はすでに世界ブランドとして世界中の半導体メーカーで採用されています。



東京エレクトロンが参入する装置セグメント

メガトレンドが半導体製造装置需要を

半導体の世界で、今、3つの大きなテクノロジーの変化が同時に起きようとしています。
 の採用」です。これら3つのトレンドがもたらすもの、それは、リーディングエッジテクノ
 エレクトロニクスは、ウェーハの300ミリ化、さらなる微細化、そしてLow-k材への移行に対応



**チップあたりのコストを削減する
ウェーハの大口径化**
 ウェーハサイズが大きくなると、1チップあたりの製造コストが安くなります。これは、200ミリウェーハに比べて、300ミリウェーハは面積が広い分1枚当りのプロセスコストがわずかに高くなるものの、より多くのチップ(2倍以上)が採取できるからです。東京エレクトロニクスは、これを事業拡大の大き

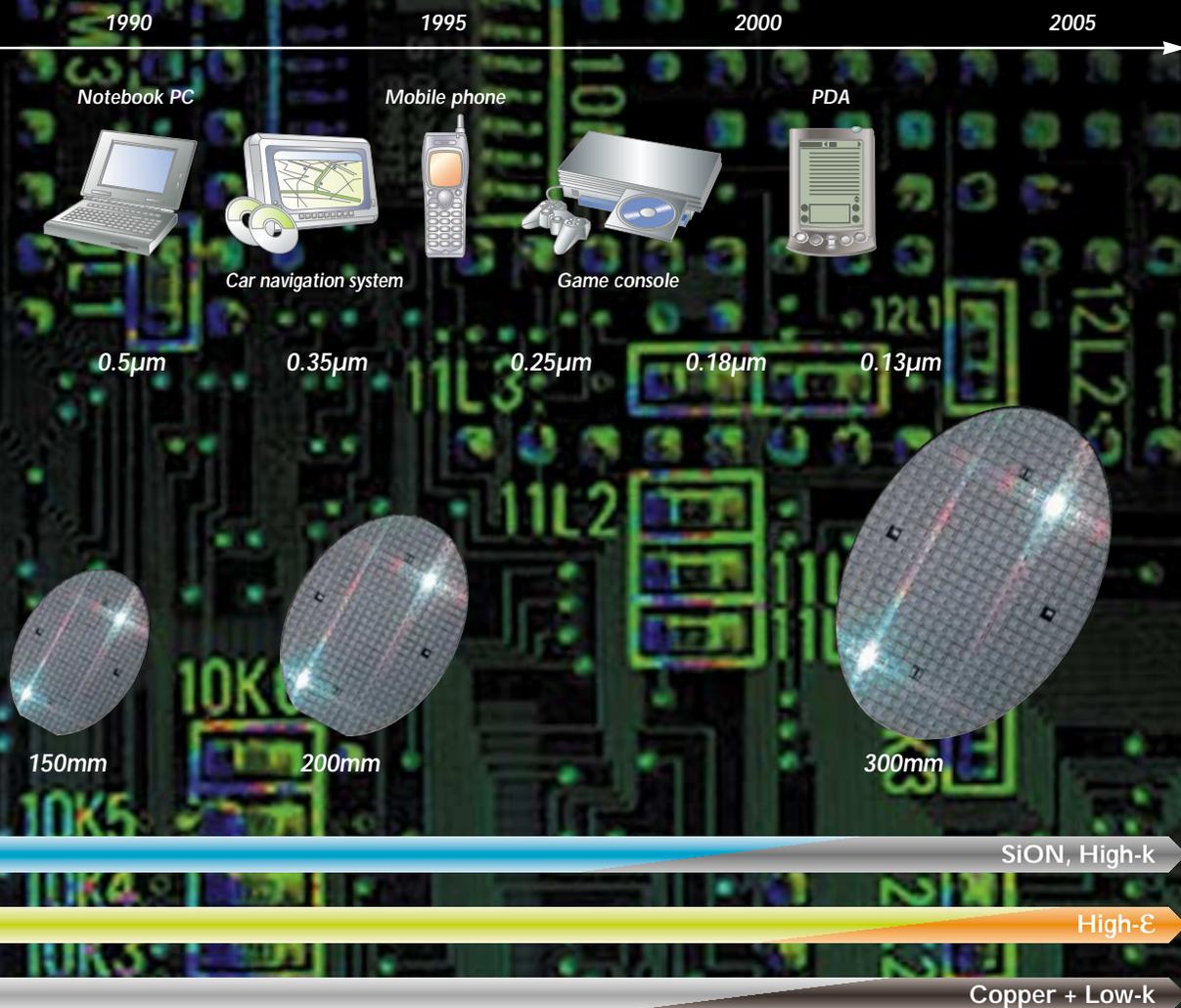
な好機と捉え、早くから300ミリ対応装置のラインアップを進めています。さらに半導体メーカーの300ミリウェーハへの移行をあらゆる局面でサポートするために、新プロセステクノロジーセンターを1998年に設立し、本格的300ミリ時代の到来に備えて万全の体制を整えています。

**半導体のさらなる高集積化を
実現する微細化**

現在の半導体製造のデザインルール(最小線幅)は、30年前と比べておよそ100分の1。これにより、より小さく、より速く、より高性能の半導体が誕生しています。また、デザインルールが小さくなれば半導体のサイズも小さくなり、その結果、同じ1枚のウェーハからより多くの半

喚起する

「ウェーハの300ミリ大口径化」、「微細化」、そして「新材料 銅と低誘電率材(Low-k材)ロジック」を追求し続ける半導体メーカーからの最新の半導体製造装置への需要です。東京エレクトロンは準備を整え、世界の半導体メーカーに時代のソリューションを提供してまいります。



導体が採れることとなります。東京エレクトロンは、微細化プロセスに直接的に関わるコータ/デベロッパ、エッチング装置の世界におけるトップサプライヤーであり、この微細化トレンドに対して、大変優位な立場にあります。

高速半導体を実現する新しい材料

0.13μm以降の世代になると、より処理速度の速い半導体を実現する上でポトルネックとなるのが信号遅延の問題です。これを解決するのが新しい材料です。トランジスタ工程(FEOL)のゲート膜/キャパシタ膜に高誘電率(High-k, High-ε)材、そして配線工程(BEOL)の配線・層間絶縁膜に銅

(Cu)・低誘電率(Low-k)材の採用という二つのドラマティックな変化が2000年代初頭に本格化します。東京エレクトロンは、従来からトランジスタ工程に優れたソリューションを提供してまいりましたが、低誘電率(Low-k)材をスピン塗布するSODコータをコアに、配線工程における統合ソリューションの提供にも取り組んでいます。

東京エレクトロンのLOW-k用ツール 統合ソリューション

半導体は、約18ヶ月ごとにチップ密度が2倍になるというムーアの法則に従って集積化することが難しくなってまいります。なぜなら信号遅延が最大のボトルネックと

Breakthrough Technology

SOD 材料



セットが提供する配線プロセスにおける

が進み、性能面で進化を続けてきました。しかし、今後は集積化だけで性能の向上を図るからです。

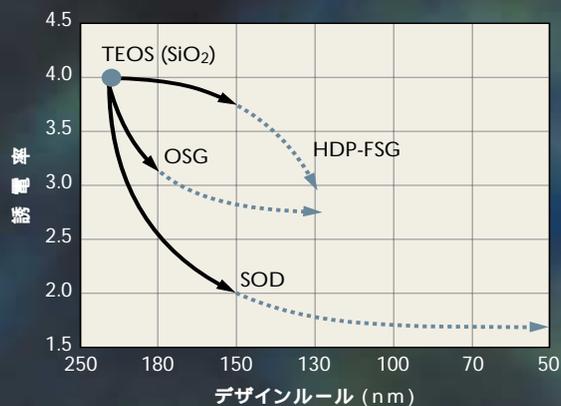
東京エレクトロンのLow-k テクノロジー・ソリューション

半導体の信号遅延対策の一つとして銅の配線材料への採用が始まりました。しかしながら、銅単独では信号遅延の完璧な阻止は難しく、銅を取り囲む層間絶縁膜に低誘電率(Low-k)材を用いることではじめて完璧なソリューションが得られます。東京エレクトロンの開発したLow-k用ツールセットは、現状の量産対応レベルとしては最も低い誘電率の絶縁膜を形成する技術を

有しており、これを半導体メーカーに提供してまいります。その技術とはスピン塗布方式。さらに低誘電率材塗布後のキュア(焼成)、エッチング、洗浄の各工程用の装置をとり揃え、配線周りの統合ソリューションを提供いたします。

東京エレクトロンは世界の様々な最先端SOD材料メーカーと長期的な提携関係を結ぶことにより、半導体メーカーが個々の用途に最も適した材料で最適なソリューションが得られる体制を整えています。

Low-k 材料



キュア(焼成)炉
・ALPHA ()-8SE



エッチング装置
・UNITY® Ver. IIe



洗浄装置
・PR200Z



SODコータ
・CLEAN TRACK ACT® 8 SOD



環境保全

社会との調和を目指して

東京エレクトロンは、地球環境を保全し、継続的に改善することが人類共通の最優先課題の一つであり、経営上もっとも配慮すべきことの一つであると捉えています。この認識に立ち、地球環境との調和を保った繁栄を実現することを常に念頭に置き、お客様・株主・従業員そして地域社会から総合的に信頼され愛される企業の構築を目指して、さまざまな環境保全活動を行っています。

これまでの環境保全活動概要

~1995年	環境管理システムの構築を検討 特定フロン全廃
1996年	第一回環境委員会開催 環境管理システムの構築を開始
1997年 - 1999年	国内主要7事業所 ISO14001認証取得
1999年	装置EHSロードマップ作成
2000年	環境会計導入開始

具体的な取り組み

ISO14001の認証取得の推進

東京エレクトロンは、環境マネジメントの国際規格であるISO14001の認証取得を強力に推進しています。1997年から取得を開始し、1999年末までに、主要国内製造工場7拠点でISO14001の取得を終了しています。認証機関としては、環境管理にも知見があり、先に認証取得したISO9001と同様にDNV(デッド・ノルスケ・ベリタス)に審査を依頼いたしました。尚、1998年に稼働を開始した東京エレクトロン宮城は現在認証取得の準備を進めており、米国工場も含めて早期の取得を目指しています。

環境に配慮した製品の開発

東京エレクトロンでは、環境負荷を低減する製品の開発を積極的に行っています。一例として、当社のコータ/デベロッパCLEAN TRACK ACT® 8や洗浄装置UW200Zは、新しいコンセプトのもとに設計され、省スペース、省エネ、省薬液等を従来に比べて大幅減とした装置です。また、当社では地球温暖化効果が低く、しかも技術的特性を損なわないフッ素ガスC₅F₈の研究開発を行い、エッチング装置のプロセスに応用しています。



尚、このC₅F₈プロセスを実用化した地球温暖化対策への積極的取り組みが認められ、1999年12月、SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International) Japanより表彰を受けました。1999年、個々の装置に対応する環境対策のための実施計画表(EHSロードマップ)が作成され、さらに環境に配慮した製品作りが進んでいます。

化学物資の管理を厳重に進める

化学物質の管理は法規制の遵守のみならず、事前の有害性評価や保管、緊急時における対応方法の検討など、総合的な管理が必要となってきています。東京エレクトロンでは、化学物質の新規導入時における審査、登録システムを構築し、化学物質による環境汚染の未然防止を目的に厳重な管理を推進しています。また、国内事業所では、化学物質ごとの環境中への排出量や廃棄物としての移動量を自ら把握し、その結果を行政や業界に報告するPRTR制度を2000年4月より導入いたしました。

廃棄物の削減、リサイクル率の向上、省エネ、省資源、グリーン購入を進める

運動の成果の一部をご紹介しますと、1998年度の国内全事業所における廃棄物量は1997年度と比較して21%低減いたしました。1996年を起点とする過去3年間のリサイクル率も、15.3%、40.9%、49.7%と大幅に上昇しています。また、事務部門を中心として紙製品、事務用品、印刷物等において環境に配慮されたエコロジー製品の購入を推進しています。

お客様・地域社会や業界への貢献

お客様には先に述べた環境に配慮した製品の開発を通じて、お客様の環境保全活動への協力を行っています。地域社会には、各地域で行われる環境保全活動への参加を通じての協力を行っています。業界には積極的な情報交換や業界スタンダードの作成活動への参画、フォーラム等への企画段階からの参画を通じての協力を行っています。これらの活動は、今後更に強化してまいります。

環境会計の導入を2001年3月期から行う

東京エレクトロンでは、環境保全活動の効果を数字の上から定量的に評価し検証してゆくために、環境会計を2001年3月期より国内事業所で導入する予定です。

ディスクロージャー(開示)

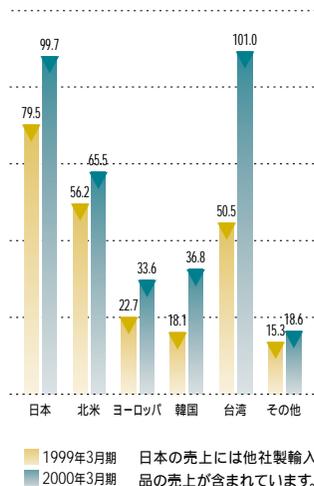
東京エレクトロンの環境保全への取り組みを幅広くご理解いただくために、2001年から当社の環境報告書を年次で開示してまいります。

営業の概況

半導体製造装置部門

半導体製造装置部門地域別売上高 (単位:10億円)

当期、全ての地域において売上高が増加しました。台湾の売上比率が最大となり、東京エレクトロンのグローバル化の進展が示された結果となりました。



1999年、半導体製造装置市場は、特に年の後半、前年からの低迷を脱しめざましい回復局面を迎えました。半導体市場は、今後数年続くと予想される上昇トレンドに入ったと見られ、半導体メーカーは、半導体の需要増を支えるための設備投資を積極的に開始いたしました。

東京エレクトロンは、すでに確立したグローバル体制と幅広い製品ラインアップにより、この市場回復に即応し、その結果、当期の半導体製造装置部門の連結売上高は、前期比46.6%増の3,551億円となりました。さらに、当部門の受注高は四半期を追うごとに増加し、特に第3、第4四半期には大きな伸びを示しました。

地域別レビュー

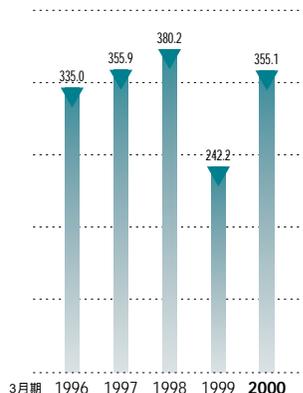
半導体製造装置部門の売上高は、当社が事業を展開する全地域で前期を上回る結果となりました。日本国内においては、半導体メーカーが引き続き既存製造ラインのアップグレードを図る一方、SOC(システム・オン・チップ)やフラッシュメモリ用ラインに対する投資も開始しました。その結果、国内売上高は、前期比25%増の997億円となりました。北米では、当社製品の市場浸透がさらに進み、前期比17%増の655億円となりました。欧州では、通信関連デバイス向けの設備投資が増加し、前期比48%増の336億円となりました。台湾においては、前期比100%増の1,010億円となり、米国や日本の大手半導体メーカーの一部が台湾ファウンドリへ生産の委託化を進めていることが要因となりました。台湾では大きな地震があったものの、半導体メーカー各社は震災被害から急速に回復いたしました。なお、台湾への売上は、当期、地域別売上の中で最大となりました。地域別売上比率の最も高い地域が国内以外となったのは、これまでで初めてのことであり、当社のグローバル化、及び、半導体メーカー同志の国際アライアンスが進展していることを物語っています。韓国においては、金融危機からの脱却に加えて、世界的にDRAM及び液晶パネルの需要が回復し始めたことで新規装置への投資が増加し、前期比103%増の368億円となりました。

製品別レビュー

当期においては、全ての製品カテゴリーで、前期比増収となりましたが、特に、ACT8シリーズを主力製品とするコータ/デベロッパ、及びUNITY®シリーズを主力製品とするエッチング装置が売上を伸ばしました。また、高速熱処理炉(FTPS)を搭載する酸化/拡散・LP-CVD装置も、半導体メーカーの新規生産ラインの増設に支えられて堅固な回復を示しました。LCD製造装置については、台湾、韓国、日本の液晶メーカーにおいて、TFT-LCDの需要増に対応する生産能力の増強が行なわれ、前期比2倍を超えるこれまでで最高の売上を達成いたしました。特にいくつかの新規工場が稼動した台湾において、大幅に拡大いたしました。

半導体製造装置部門売上高
(単位:10億円)

半導体及びLCDメーカーの設備投資が再燃し、売上高が大きく回復しました。



最近市場に投入した新製品としては、CLEAN TRACK ACT® 8 SOD、WX-8ウェーハレベル・パーンイン&テスト装置、UW200Z・PR200Z洗浄装置などがありますが、現在、半導体メーカーの量産ラインに採用していただけるよう、拡販への努力を続けています。CLEAN TRACK ACT® 8 SODは、当社のベストセラーであるコータ/デベロッパCLEAN TRACK ACT® 8と同じプラットフォームを持ち、低誘電率材を配線層間にスピン塗布する装置です。スピン塗布方式の優位性が認められつつある中、当製品の大きな成長が期待されます。WX-8は、半導体チップを切り出す前のウェーハ形状におけるパーンインテストを可能にした画期的な新製品です。従来のパッケージング後のパーンインテストと比較し、半導体メーカーにおいて大きなコスト削減効果が期待されます。UW200Zは、省スペース化を図り、薬液・純水の消費量を大幅に削減したことにより、フロントエンド・オブ・ライン(FEOL)工程における洗浄装置の新しいスタンダードをつくりました。PR200Zは、ロジックおよびSOCにおいて急増するバックエンド・オブ・ライン(BEOL)工程にユニークかつ高性能の洗浄技術を提供する装置です。特に高いアスペクト比のビアホールにおいて高い洗浄能力を発揮します。これらの新製品はすでに市場に投入され初めており、半導体メーカーからの評価は極めて高く、順調な滑り出しを見せています。

また、将来さらなる成長が期待される300ミリウェーハ用装置にも、これらの技術が搭載され、出荷が始まっています。

コンピュータ・システム部門及び電子部門

コンピュータ・システム部門

当期、引き続き低迷する国内法人需要の影響で、当部門の連結売上高は前期比4.0%減の124億円となりました。しかしながら、昨年後半からいよいよ日本の企業

業にもIT関連投資の気運が盛り上がり、インターネットビジネスの根幹を支えるサーバー製品や高速ネットワーク関連機器が好調に売上を伸ばしました。

特に、Extreme Networks社のGigabit Ethernetスイッチをはじめとするネットワーク機器の売上

が前期の1.5倍、また 今後の市場拡大が見込まれるSAN (Storage Area Network) 関連製品の中心にあるFibre Channel製品の売上が2倍以上に拡大しました。今後もこの分野を当部門の中核を成す分野としてさらなる製品ラインアップの強化を進めてまいります。当期、Pathlight Technology社のルーター製品が新たに取り扱い製品に加わりました。



Brocade Communications Systems, Inc.
Fibre Channel Fabric Switch

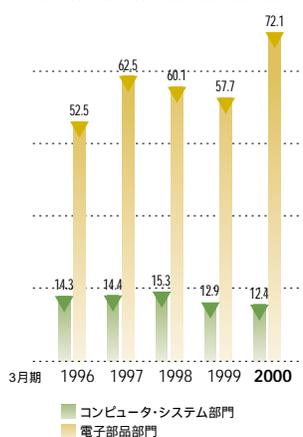
Emulex Corp.
Fibre Channel PCI Host Adapter

GenRad, Inc.
Combination Test System

コンピュータ・システム部門及び電子部品部門売上高

(単位:10億円)

コンピュータ・システム部門の売上高は横ばい、電子部品部門の売上高はこれまでの最高を更新いたしました。



AMDはAMD社の登録商標です。

PowerPCはIBM社の登録商標であり、IBM社からのライセンスを受けてモトローラ社が使用しています。



一方、e-ビジネス分野の市場拡大、それに伴うセキュリティシステムへの要求の高まりの中、当期よりSSLアクセラレータのリーディング・カンパニーであるnCipher社との取り引きを開始いたしました。

また、F5 Networks社との取り引き開始により、インターネット・トラフィックの管理製品の充実を図りました。

さらに、当部門では、製品のディストリビューションに加えて、最適な方法でお使いいただくためのコンサルテーションサービスやアウトソーシングサービスの開発にも力を入れています。Hewlett-Packard社製品をベースに快適なエンジニアリング環境を提供する“TEL Engineering Office™、また、企業データをデータセンターにお預かりして管理するアウトソーシングサービス DigiGuard™も軌道に乗ってまいりました。新しい分野への取り組みとしては、Cycomm社の耐環境コンピュータの取り扱いも始めています。

電子部品部門

1998年7月、電子部品ビジネスが東京エレクトロンの100%子会社である東京エレクトロニクス株式会社(TED)へ全面移管された後、当期末初の全会計年度を終了いたしました。

電子部品部門の当期連結売上高は、前期比24.8%増の721億円となり、これまでの最高売上高を達成いたしました。特に、通信・ネットワーク関連並びにパソコン関連デバイスの売上が著しい伸びを示し、民生用エレクトロニクス関連も堅調でした。ここ数年、これら成長性の高い分野の強化を戦略の中心に据え、高付加価値商品の比率を高めてきた成果の現われと考えます。特に、ここ2年以内に取り引き

を開始した主要4社の商品の取り扱い高は、前期比2倍以上の伸びを示し、短期のうちに全体売上の5%近くに達しました。今後も高成長が見込まれる分野での新商品の導入を積極的に図ってまいります。

当部門では、世界中から選りすぐられた約40社の幅広い商品のディストリビューションに加えて、独自の設計・開発によるオリジナル製品を提供しています。中でもフラッシュメモリーコントローラTE4000シリーズは、マルチメディアをサポートするデバイスとして今後大きな成長が見込まれる有望な製品です。また、豊富な経験と最高の設備を生かし、お客様のニーズに合わせたLSIの設計受託を年間100件以上行なっています。最近では特にASICを中心に設計規模が大型化しています。

また、当部門では、電子商取引の強化・拡充にも積極的に取り組んでいます。当期、EDIによる取引は出荷件数全体の約80%にまで拡大し、オペレーションの効率化に大きく寄与いたしました。

財務報告

売上及び利益

売上の状況

2000年3月期の連結売上高は、半導体産業が1998年の低迷から急速に回復し、半導体メーカーの設備投資や先端技術投資が活発化したことにより、前期比40.4%増の4,407億円となりました。地域別に見ると、国内売上高は前期比22.8%増加の1,840億円で、海外売上高は56.6%と大きく増加し、2,567億円となりました。なお、海外売上高は2年連続で国内売上高を上回りました。

国内及び海外売上高
(単位:10億円)

海外売上高は56.6%増加し、2年連続して国内売上高を上回りました。



部門別では、LCD製造装置を含む半導体製造装置部門の売上高が、前期比46.6%増加し3,551億円となりました。コンピュータ・システム部門の売上高は微減の124億円、電子部品部門の売上高は24.8%増の721億円でした。

当社は2000年3月期より受注額および受注残高を連結で開示いたします。半導体製造装置部門の受注高は、特に非メモリーメカ - 及びファウンドリ(受託生産メーカー)の旺盛な設備投資に支えられ5,205億円、受注残高は2,495億円に増加しました。当期第4四半期に見られた強い受注 Momentumから、2001年3月期も引き続き売上高の伸長が期待できます。なお、単体の前期(1999年3月期)における受注高は1,981億円、受注残高は840億円でした。

当社の日本からの輸出売上は、原則円建てで行なわれま。そのため、円高時には販売価格の割高感が生じることもありますが、外国為替の変動が収益に与える影響は軽微です。また、主に外貨建てで取り引きされる輸入仕入については、取り扱い比率が小さく、こちらも外国為替の変動の影響は軽微です。

売上原価、販売費及び一般管理費

売上原価は、前期比34.5%増の3,038億円となり、売上高増加率を大きく下回る範囲に留まりました。その結果、売上原価率は前期の72.0%から、68.9%に改善されました。売上総利益は、55.8%増の1,369億円となり、売上総利益率は、売上高の増加と生産性の向上及びコスト削減努力が反映され、3.1ポイント上昇し、31.1%となりました。

売上高及び売上総利益
(単位:10億円)

売上高の増加と生産性改善の努力が実り売上総利益率は3.1ポイント改善しました。



販売費及び一般管理費(SG&A)は、24.1%増の1,011億円となりましたが、徹底したコスト管理の成果が現われ、これもまた、売上高増加率よりも低い範囲に留まりました。販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は、38.3%増の371億円となりました。研究開発費は、主に0.13ミクロン以下対応の製品開発、300ミリ対応装置開発や新規分野に

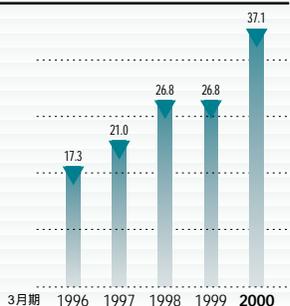
投じられました。研究開発については、たとえ市場の低迷期であっても、継続的に適正規模の研究開発投資を行なうことが市場競争における優位性を維持するためのキーフaktorとなり、市場回復時に十分な利益を享受することを可能にするものと考えます。

営業利益は、売上高の増加率が費用の増加率を大幅に上回り、前期比5倍を超える358億円となりました。その結果、営業利益率は2.0%から8.1%に回復しました。

研究開発費

(単位:10億円)

研究開発費は、次世代の技術開発に対する積極的な投資により、上昇しました。



その他収益(費用)及び当期純利益

その他費用純額は、主に固定資産売却損、除去損及び過年度分の特許使用料により、61億円に増加しました。税金

等調整前当期純利益は、前期比約5倍の297億円となりました。当期純利益は、前期の19億円から198億円に増加し、1株当たりの当期利益は10円70銭から110円64銭に増加しました。配当金は前期比2円増加の14円、配当性向は好業績時の水準に戻り、12.7%となりました。

1株当たり当期純利益

(単位:円)

潜在株式調整後の1株当たり利益は、約100円増加し110.64円になりました。



配当金及び配当性向

(単位:円/%)

当期純利益の回復により、1株当たり配当金を当初予定から2円増加の14円としました。

■ 配当金
■ 配当性向



	単位:百万円 (売上高に占める割合)			単位:千米ドル
	2000年	1999年	1998年	
売上高	¥440,729 (100.0)	¥313,820 (100.0)	¥455,585 (100.0)	\$4,151,945
売上原価	303,839 (68.9)	225,962 (72.0)	304,825 (66.9)	2,862,355
売上総利益	136,890 (31.1)	87,858 (28.0)	150,760 (33.1)	1,289,590
販売費及び一般管理費	101,074 (22.9)	81,475 (26.0)	87,464 (19.2)	952,181
営業利益	35,816 (8.1)	6,383 (2.0)	63,296 (13.9)	337,409
その他収益(費用)	(6,127) —	(345) —	(462) —	(57,720)
税金等調整前当期純利益	29,689 (6.7)	6,038 (1.9)	62,834 (13.8)	279,689
法人税等	9,836 (2.2)	4,167 (1.3)	32,825 (7.2)	92,661
当期純利益	¥ 19,848 (4.5)	¥ 1,866 (0.6)	¥ 30,009 (6.6)	\$ 186,981

財政状態及びキャッシュフロー

財政状態

2000年3月期末の流動資産は、前期末比29.0%増加し、3,752億円となりました。主な増加の要因としては、売上増を反映して受取手形および売掛金、たな卸資産が増加したことによるものです。しかしながら、たな卸資産回転率は、前期の3.33から4.39に、受取手形及び売掛金回転率は、1.89から2.79に改善されています。流動負債は前期の2倍を超える1,465億円となりました。これは売上増加に対応した運転資金需要をまかなうため短期借入を増加させたこと、また、受注増に対応して生産を拡大したため、買掛金が増加したことによるものです。運転資本は2,287億円に増加し、流動比率は、流動資産の増加により前期の4.2対1から2.6対1に低下しましたが、なお、高い流動性を維持しています。総資産は、主に流動資産の増加と有形固定資産の増加により、20.4%増の4,995億円となりました。

長期債務については、2000年9月に償還を迎える300億円の社債が固定負債から流動負債に振り替えられたことにより、前期から13.4%減少し、673億円となりました。

運転資本及び流動比率

(単位: 10億円 / 倍)

運転資本は増加しました。流動比率は前期より低下したものの、引き続き高い流動性を維持しました。

■ 運転資本
■ 流動比率



株主資本については、主に連結剰余金の増加により、6.2%増の2,736億円となりましたが、株主資本比率は、前期の62.1%に対して54.8%となりました。ROEは前期から6.8ポイント上昇し、7.5%に改善しました。

株主資本比率

(単位: %)

株主資本比率は、売上高の増加に起因する流動資産の増加を反映して低下しましたが引き続き高水準を維持しました。



	単位: 百万円 (総資産に占める割合)		単位: 千米ドル	
	2000年	1999年	2000年	1999年
資産合計	¥499,499 (100.0)	¥414,903 (100.0)	\$4,705,596	\$3,752,000
受取手形及び売掛金	175,153 (35.0)	140,746 (33.9)	1,650,052	1,150,000
現金及び預金	79,519 (15.9)	46,910 (11.3)	749,119	400,000
たな卸資産	112,481 (22.5)	88,085 (21.2)	1,059,642	800,000
投資その他の資産	25,522 (5.1)	32,063 (7.7)	240,433	200,000
有形固定資産	97,726 (19.6)	92,092 (22.2)	920,641	900,000
負債合計	225,862 (45.2)	156,885 (37.8)	2,127,763	1,465,000
支払手形及び買掛金	62,574 (12.5)	35,019 (8.4)	589,487	300,000
短期借入金	23,998 (4.8)	21,657 (5.2)	226,076	200,000
未払法人税等	11,843 (2.4)	1,488 (0.4)	111,569	100,000
長期借入金及び社債	67,278 (13.5)	77,709 (18.7)	633,801	700,000
資本合計	¥273,603 (54.8)	¥257,716 (62.1)	\$2,577,513	\$2,500,000

2000年3月期末の転換社債の残高は、156億円となりました。転換社債の潜在株式数は、期末発行済株式数の2.8%となります。

株主資本及び 株主資本利益率(ROE)

(単位:10億円/%)

株主資本は6.2%増加し、ROEは7.5%に改善しました。

■ 株主資本
— 株主資本利益率



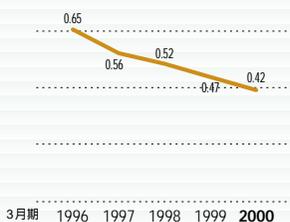
キャッシュ・フロー

営業活動から生じたキャッシュフローは、前期の498億円に対して、49.6%減の251億円となりました。当期純利益と減価償却費を合算したネット・キャッシュ・フローは、主に当期純利益の増加により、前期比2倍の393億円となりました。尚、当社では、売上拡大の局面においては、売上債権の現金化よりもサイトの短い仕入支出が先行するため、現金の減少をもたらします。当期、営業活動から生じたキャッシュフローが減少したのは、急激な売上増と生産増に起因する受取手形及び売掛金とたな卸資産の増加が主たる要因です。

負債比率

(単位:倍)

堅固なキャッシュ・フローにより、借入金への依存がおさえられ、負債比率は0.42倍に改善しました。比率は期首・期末平均で計算しています。



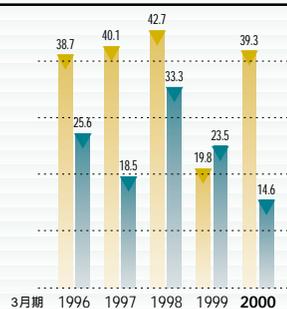
投資活動に使用したキャッシュフローは、前期の243億円に対して、33.5%減の162億円となりました。このうち、有形固定資産の取得による支出は146億円でした。当社は、2000年3月期より、固定資産の取得による支出に自社装置を固定資産に振替えた金額を含めておりません。この金額を含めた有形固定資産の設備投資額は190億円、主に評価用機械装置に投じられ、建物や土地への大型投資はありませんでした。尚、1998年から1999年前半にかけては、半導体業界の低迷に対応し設備投資を抑えましたが、2001年3月期には、生産能力拡大や新技術対応のために設備投資の増強を見込んでいます。

ネット・キャッシュ・フロー 及び設備投資額

(単位:10億円)

徹底した財務マネジメントにより設備投資はネット・キャッシュ・フローの範囲内にあります。

■ ネット・キャッシュ・フロー
■ 設備投資額



財務活動によるキャッシュフローについては、前期の財務活動に使用したキャッシュフロー482億円に対し、当期、財務活動から得られたキャッシュフロー236億円となりました。130億円の短期借入金の増加、及び200億円の無担保普通社債の発行が主な要因です。

現金及び現金同等物の期末残高は、大きく増加し、前期の477億円に対し、795億円となりました。当社はプラスのキャッシュ・フローを持ち、負債の比率は低く、運転資本が豊富であることから、資金流動性が高く、半導体産業の上昇サイクル時には需要の拡大に応じて国際的に業容を拡大できる健全な財務基盤を備えていると考えます。

連結貸借対照表

東京エレクトロン株式会社及び連結子会社
2000年3月期及び1999年3月期

資産の部	百万円		千米ドル
	2000年	1999年	2000年
流動資産:			
現金及び預金	¥ 79,519	¥ 46,910	\$ 749,119
有価証券(注記3)	835	835	7,866
受取手形及び売掛金	175,153	140,746	1,650,052
貸倒引当金	(1,029)	(1,134)	(9,694)
たな卸資産(注記4)	112,481	88,085	1,059,642
繰延税金資産(注記7)	5,306	-	49,986
前払費用及びその他流動資産 ¹	2,892	15,306	27,245
流動資産合計	375,157	290,748	3,534,216
投資その他の資産:			
投資有価証券(注記3)	9,010	8,633	84,880
無形固定資産及びその他資産 ¹	14,367	23,430	135,346
繰延税金資産(注記7)	2,145	-	20,207
投資その他の資産合計	25,522	32,063	240,433
為替換算調整勘定	1,094	-	10,306
有形固定資産:			
土地	16,554	17,163	155,949
建物及び構築物	89,795	81,527	845,926
機械装置・運搬具及び工具器具備品	67,520	62,777	636,081
建設仮勘定	877	97	8,262
合計	174,746	161,564	1,646,218
減価償却累計額	77,020	69,472	725,577
有形固定資産合計	97,726	92,092	920,641
資産合計	¥499,499	¥414,903	\$4,705,596

連結財務諸表注記参照

1. 1999年3月期の子会社への短期貸付金は、前払費用及びその他流動資産に含めております。同様に、1999年3月期の子会社への投資及び長期貸付金は、無形固定資産及びその他資産に含めております。

負債、少数株主持分及び資本の部

	百万円		千米ドル
	2000年	1999年	2000年
流動負債:			
短期借入金(注記6).....	¥ 23,998	¥ 21,657	\$ 226,076
1年以内返済予定長期借入金及び社債(注記6).....	32,699	1,536	308,045
支払手形及び買掛金.....	62,574	35,019	589,487
未払法人税等.....	11,843	1,488	111,569
賞与引当金.....	7,375	4,117	69,477
未払費用及びその他流動負債.....	7,969	5,238	75,073
流動負債合計.....	146,458	69,055	1,379,727
長期借入金及び社債(注記6).....	67,278	77,709	633,801
退職給与引当金.....	11,581	9,344	109,100
その他固定負債.....	545	777	5,135
負債合計.....	225,862	156,885	2,127,763
為替換算調整勘定.....	-	276	-
少数株主持分.....	34	26	320
資本の部:			
資本金(注記8).....	47,163	45,532	444,305
普通株式、額面1株当たり50円 授權株式数: 300,000,000株 発行済株式総数: 2000年3月31日現在 175,659,848株 1999年3月31日現在 174,623,995株			
資本準備金(注記8).....	70,225	68,594	661,564
連結剰余金.....	157,876	144,715	1,487,292
自己株式(注記9).....	(1,661)	(1,125)	(15,648)
資本合計.....	273,603	257,716	2,577,513
負債、少数株主持分及び資本合計.....	¥499,499	¥414,903	\$4,705,596

連結損益計算書

東京エレクトロン株式会社及び連結子会社

1998年3月期、1999年3月期及び2000年3月期

	百万円			千米ドル
	2000年	1999年	1998年	2000年
売上高	¥440,729	¥313,820	¥455,585	\$4,151,945
売上原価	303,839	225,962	304,825	2,862,355
売上総利益	136,890	87,858	150,760	1,289,590
販売費及び一般管理費	101,074	81,475	87,464	952,181
営業利益	35,816	6,383	63,296	337,409
その他収益(費用):				
受取利息及び受取配当金	276	898	1,664	2,600
支払利息	(1,960)	(2,003)	(1,640)	(18,464)
過年度特許使用料	(1,575)	-	-	(14,837)
ゴルフ会員権評価損	(1,253)	-	-	(11,804)
その他	(1,615)	760	(486)	(15,215)
税金等調整前当期純利益	29,689	6,038	62,834	279,689
法人税等(注記7):				
法人税・住民税及び事業税	14,545	4,167	32,825	137,023
法人税等調整額	(4,709)	-	-	(44,362)
少数株主利益	5	5	-	47
当期純利益	¥ 19,848	¥ 1,866	¥ 30,009	\$ 186,981
1株当たり情報:				
	円			米ドル
当期純利益	¥ 113.53	¥ 10.70	¥ 174.68	\$ 1.07
潜在株式調整後当期純利益	110.64	10.70	168.43	1.04
配当金	14.00	12.00	30.00	0.13

連結財務諸表注記参照

連結株主持分計算書

東京エレクトロン株式会社及び連結子会社

1998年3月期、1999年3月期及び2000年3月期

	百万円			千米ドル
	2000年	1999年	1998年	2000年
資本金				
期首残高	¥ 45,532	¥ 45,445	¥ 30,755	\$ 428,940
転換社債株式転換による増加(注記8)	1,631	87	5,476	15,365
新株引受権付社債の権利行使による増加	-	-	9,214	-
期末残高	47,163	45,532	45,445	444,305
資本準備金				
期首残高	68,594	68,507	53,823	646,199
転換社債株式転換による増加(注記8)	1,631	87	5,476	15,365
新株引受権付社債の権利行使による増加	-	-	9,208	-
期末残高	70,225	68,594	68,507	661,564
連結剰余金				
期首残高	144,715	147,082	122,914	1,363,307
連結子会社増加に伴う増加(減少)額	(7,309)	(210)	(816)	(68,856)
過年度税効果調整額	2,717	-	-	25,596
当期純利益	19,848	1,866	30,009	186,981
株主配当金	(2,095)	(3,665)	(4,689)	(19,736)
取締役賞与金	-	(358)	(336)	-
期末残高	157,876	144,715	147,082	1,487,292
自己株式(注記9)	(1,661)	(1,125)	(25)	(15,648)
(1998年:4,101株、1999年:247,191株、 2000年:303,761株)				
株主持分期末残高	¥273,603	¥257,716	¥261,009	\$2,577,513

連結財務諸表注記参照

連結キャッシュ・フロー計算書

東京エレクトロン株式会社及び連結子会社

2000年3月期

	百万円	千米ドル
	2000	2000
営業活動によるキャッシュ・フロー:		
税金等調整前当期純利益	¥29,689	\$279,689
減価償却費	19,446	183,194
退職給与引当金の増加額	2,153	20,283
貸倒引当金の増加額	213	2,007
賞与引当金の増加額	3,175	29,911
受取利息及び配当金	(276)	(2,600)
支払利息	1,964	18,502
為替差損	747	7,037
社債発行費	101	951
新株発行費	24	226
前期損益修正益	(398)	(3,749)
固定資産売却損益	(392)	(3,693)
固定資産等除却損	2,149	20,245
ゴルフ会員権評価損	1,253	11,804
売上債権の増加額	(31,675)	(298,398)
たな卸資産の増加額	(27,196)	(256,203)
仕入債務の増加額	22,416	211,173
未収消費税等の増加額	(3,542)	(33,368)
その他	10,676	100,573
小計	30,527	287,584
利息及び配当金の受取額	280	2,638
利息の支払額	(1,923)	(18,116)
法人税等の支払額	(3,757)	(35,394)
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,127	236,712
投資活動によるキャッシュ・フロー:		
定期預金の払戻による収入	150	1,413
有形固定資産の取得による支出	(14,577)	(137,325)
有形固定資産の売却による収入	1,566	14,753
無形固定資産の取得による支出	(4,100)	(38,625)
無形固定資産の売却による収入	26	245
投資有価証券の取得による支出	(500)	(4,710)
投資有価証券の売却による収入	103	970
貸付による支出	(68)	(641)
貸付金の回収による収入	90	848
その他	1,118	10,533
投資活動によるキャッシュ・フロー	(16,192)	(152,539)
財務活動によるキャッシュ・フロー:		
短期借入金の純増加額	13,022	122,675
コマーシャル・ペーパーの純減少額	(10,000)	(94,206)
長期借入による収入	5,700	53,698
長期借入金の返済による支出	(2,477)	(23,335)
社債の発行による収入	19,899	187,461
自己株式の純増加額	(454)	(4,277)
配当金の支払額	(2,095)	(19,736)
その他	(25)	(236)
財務活動によるキャッシュ・フロー	23,570	222,044
現金及び現金同等物に係る換算差額	(469)	(4,418)
現金及び現金同等物の増加額	32,036	301,799
現金及び現金同等物期首残高	46,761	440,518
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高	722	6,802
現金及び現金同等物期末残高	¥79,519	¥749,119

前期以前のキャッシュ・フロー・データに関しては注記2(k)を参照下さい。

連結財務諸表注記

東京エレクトロン株式会社及び連結子会社

1. 連結財務諸表作成の基本事項

添付の東京エレクトロン株式会社及びその連結子会社(以下「当社」)の連結財務諸表は、わが国の一般に公正妥当と認められた会計基準に準拠し、証券取引法第24条第1項に基づく有価証券報告書に記載された連結財務諸表に基づいて作成されました。

ただし、海外の読者のために、連結財務諸表の表示及び注記の記載について必要な調整を加えております。

2. 重要な会計方針の要約

(a) 連結基準

本連結財務諸表は、親会社及び28社全ての子会社を連結対象としています。

前年度まで非連結であった子会社7社は、連結財務諸表に対する総合的な影響が増したため、2000年3月期より連結対象としました。これに伴い、2000年3月期の期首連結剰余金は7,309百万円減少しました。

連結会社間の重要な債権債務・内部取引・未実現損益は全て消去されています。また、連結子会社の事業年度は、全て親会社の事業年度と一致しています。

米ドル金額は、読者の便宜のために、2000年3月期の期末日レートである1ドル=106.15円で換算しています。この換算は、円価がそのレートで米ドルに換金できることを意味していません。

(b) 外貨換算方法

外貨建債権・債務は、決算期末日の取引レートで日本円に換算しています。ただし、先物予約のあるものは、契約レートで換算しています。長期の外貨建資産・負債は、取得日あるいは発生日のレートで換算しています。外貨建の財務諸表は、日本の外貨建取引等会計処理基準で換算しています。

(c) 有価証券及び投資有価証券

有価証券及び投資有価証券は、主に総平均法による原価法を採用しております。

(d) たな卸資産

たな卸資産は、主に個別法による原価法を採用しております。

(e) 有形固定資産

有形固定資産は、取得原価で表示されています。減価償却については、親会社及び国内子会社では、税法が定める各資産の耐用年数に基づき、定率法(1998年4月1日以降取得の建物は定額法)で計算されます。海外子会社では、各資産の耐用年数に基づき、主に定額法で計算されています。

(f) 退職金

親会社及び国内子会社は、従業員の退職金支給に備えるため、外部積立の退職年金制度を採用しています。

また、役員については内規で定める必要金額を、従業員については税法限度額あるいは退職金規程に定める金額を引当しています。本制度により、従業員は、最終給与金額・勤務年数及び退職事由に基づいて計算された一時金の支給を受けます。

(g) リース

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(h) 法人税等

1999年4月1日に実施された会計基準の変更により、財務会計上の資産・負債と税務上の資産・負債との一時差異につき、繰延税金資産・負債を計上しています。

(i) デリバティブ

当社は、外貨建取引の為替リスクを減少させることのみを目的としてデリバティブを利用しております。デリバティブ取引は、外貨建資産及び負債ならびに成約高の範囲内に限られており、投資目的のための取引は行っておりません。

(j) 1株当たり情報

1株当たり当期純利益は、各年の加重平均発行済株式数に基づき計算されています。

1株当たり配当金は、発生ベースで計算され、3月31日に終了する決算期以降に決議された、あるいは決議予定の配当金で、当期に対応するものを含みます。

(k) キャッシュ・フロー計算書

当期より、連結財務諸表規則に基づく連結キャッシュ・フロー計算書を開示しております。

前期以前のキャッシュ・フロー計算書については、同様式への組み替えは行っておらず、読者の判断を誤らせないため、掲載しておりません。前期以前のキャッシュ・フロー計算書の要約は、次の通りです。

	百万円	
	1999	1998
営業活動によるキャッシュ・フロー	¥ 49,828	¥ 17,473
投資活動によるキャッシュ・フロー	(24,346)	(45,326)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(48,189)	66,878
為替レートの変動による影響	(1,440)	873
現金及び現金同等物の増加(減少)額	(24,147)	39,898
現金及び現金同等物期末残高	¥47,745	¥71,892

(1) 現金及び現金同等物

キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物には、現金・銀行預金及び満期まで3カ月以内の定期預金が含まれています。

3. 有価証券及び投資有価証券

2000年及び1999年3月31日現在の有価証券の内訳は、次の通りです。

	百万円		千米ドル
	2000	1999	2000
上場有価証券	¥825	¥825	\$ 7,772
その他	10	10	94
合計	¥835	¥835	\$ 7,866

2000年及び1999年3月31日現在の投資有価証券の内訳は、次の通りです。

	百万円		千米ドル
	2000	1999	2000
上場有価証券	¥8,086	¥8,107	\$ 76,175
投資信託	810	216	7,631
その他	114	310	1,074
合計	¥9,010	¥8,633	\$ 84,880

4. たな卸資産

2000年及び1999年3月31日現在のたな卸資産の内訳は、次の通りです。

	百万円		千米ドル
	2000	1999	2000
製品	¥ 38,909	¥32,595	\$ 366,547
仕掛品・原材料・貯蔵品	73,572	55,490	693,095
合計	¥112,481	¥88,085	\$ 1,059,642

5. 担保提供資産

2000年及び1999年3月31日現在で、担保に供している資産はありません。

6. 短期借入金・長期借入金及び社債

短期借入金の2000年3月31日現在の平均利率は1.47%です。2000年及び1999年3月31日現在の長期借入金及び社債の内訳は、次の通りです。

	百万円		千米ドル
	2000	1999	2000
2003年満期0.90%無担保転換社債	¥15,601	¥18,864	\$ 146,971
2000年満期2.45%無担保社債	30,000	30,000	282,619
2002年満期2.00%無担保社債	20,000	20,000	188,413
2004年満期1.39%無担保社債	20,000	-	188,413
銀行借入金	14,376	10,381	135,430
1年以内返済分	(32,699)	(1,536)	(308,045)
合計	¥67,278	¥77,709	\$ 633,801

2003年満期0.90%無担保転換社債は、社債権者の選択により、2003年9月29日まで普通株式に転換することができます。2000年3月31日現在、転換価額は1株当たり3,150.00円です。この価額は特定の条件で調整されることがあります。

7. 法人税等

親会社及び国内連結子会社の法定実効税率は、2000年3月期で約42%、1999年3月期で約48%です。

2000年3月31日現在の当社の繰延税金資産・負債の主な内訳は、次の通りです。

	百万円	千米ドル
繰延税金資産		
税務上の繰越欠損金	¥ 4,882	\$ 45,992
たな卸資産に係る未実現利益	3,172	29,882
賞与引当金	1,350	12,718
固定資産に係る未実現利益	1,173	11,050
未払事業税	1,007	9,487
退職給与引当金	838	7,894
ゴルフ会員権評価損	519	4,889
その他	2,188	20,613
繰延税金資産小計	15,129	142,525
評価性引当額	(5,936)	(55,921)
繰延税金資産合計	9,193	86,604
繰延税金負債		
特別償却準備金	(1,028)	(9,684)
貸倒引当金に係る未実現利益	(314)	(2,958)
輸入製品国内市場開拓準備金	(252)	(2,374)
その他	(173)	(1,630)
繰延税金負債合計	(1,767)	(16,646)
繰延税金資産の純額	¥ 7,426	\$ 69,958

取締役・監査役及び業務執行責任者

(2000年7月1日現在)



左から吉田光孝、東 哲郎、常石哲男、田中健生

取締役

東 哲郎

東京エレクトロン株式会社
代表取締役社長

常石哲男

東京エレクトロン株式会社
代表取締役専務

田中健生*

東京エレクトロン株式会社
代表取締役常務

吉田光孝

東京エレクトロン株式会社
代表取締役常務

栗山敬一郎*

東京エレクトロンデバイス株式会社
代表取締役会長

松葉邦行**

東京エレクトロンFE株式会社
代表取締役会長

高嶋 浩*

東京エレクトロン九州株式会社
代表取締役会長

井上準一

東京エレクトロン山梨株式会社
代表取締役会長

砂原幸雄

株式会社東京放送
代表取締役社長

監査役

石橋寛介

東京エレクトロン株式会社

三好和昭

東京エレクトロン株式会社

鈴木孝則

東京エレクトロン株式会社

志甫 溥

株式会社東京放送
代表取締役会長

* 報酬委員会委員

** 倫理担当取締役

業務執行責任者

(コーポレート・シニア・スタッフ: CSS)

東 哲郎

代表取締役社長

常石哲男

代表取締役専務

田中健生

代表取締役常務

吉田光孝

代表取締役常務

本田祐一

常務理事、財務部・経理部・販売事務部・情報システム担当

石井浩介

理事、人事部・総務部・管理部門グローバルオペレーション担当

小松原隆一

マーケティング本部長

松本 悟

理事、開発・技術担当

松岡孝明

参与、コーポレート技術戦略・知的財産権担当

栗木康幸

拡散システムB.U.G.M.

小野里充

エッチングシステムB.U.G.M.

井上芳徳

テストシステムB.U.G.M.

高森秀之

クリーントラックB.U.G.M.

岩津春生

洗浄システムB.U.G.M.

富田 博

LCDシステムB.U.G.M.

春原 清

欧米営業推進本部長

佐藤博信

アジア営業推進本部長

溝口 信

国内営業推進本部長

黒岩健吾

東京エレクトロン東北株式会社代表取締役社長

井上康夫

東京エレクトロン山梨株式会社代表取締役社長

山城 恵

東京エレクトロン九州株式会社代表取締役社長

久保寺正男

東京エレクトロン宮城株式会社代表取締役社長

原 護

東京エレクトロンEE株式会社代表取締役社長

古垣圭一

東京エレクトロンFE株式会社代表取締役社長

砂川俊昭

東京エレクトロン デバイス株式会社代表取締役社長

Barry R. Rapozo

TOKYO ELECTRON AMERICA, INC. 取締役社長

Gerald Thurgood

TOKYO ELECTRON EUROPE LTD. 取締役社長

郭 泰均

TOKYO ELECTRON KOREA LTD. 取締役社長

黄 民奇

TOKYO ELECTRON TAIWAN LTD. 取締役社長

(注) B.U.G.M. はビジネス・ユニット・ジェネラル・マネージャーの略称です。

グローバルネットワーク

(2000年6月28日現在)

国内

東京エレクトロン株式会社・本社

〒107-8481 東京都港区赤坂5-3-6 TBS放送センター
Tel: 03-5561-7000
Fax: 03-5561-7400
URL: <http://www.tel.co.jp/>

事業所

府中テクノロジーセンター 大阪支社 九州支社
東北事業所 山梨事業所 技術開発センター
営業所
仙台営業所 名古屋営業所

東京エレクトロン東北株式会社

本社・東北事業所
〒023-1101 岩手県江刺市岩谷堂字松長根52
Tel: 0197-35-5101
Fax: 0197-35-7005

相模事業所

〒220-0101 神奈川県津久井郡城山町町屋1-2-41
Tel: 042-782-8111
Fax: 042-783-1580

東京エレクトロン山梨株式会社

本社・藤井事業所
〒407-8511 山梨県韮崎市藤井町北下条2381-1
Tel: 0551-22-8611
Fax: 0551-23-2450

穂坂事業所

〒407-0192 山梨県韮崎市穂坂町三ツ沢650
Tel: 0551-22-8611
Fax: 0551-23-4092

東京エレクトロン九州株式会社

本社・佐賀事業所
〒841-0074 佐賀県鳥栖市西新町1375-41
Tel: 0942-81-1800
Fax: 0942-81-1755

熊本事業所

〒869-1197 熊本県菊池郡菊陽町津久礼2655
Tel: 096-292-3111
Fax: 096-292-3295

大津事業所

〒869-1232 熊本県菊池郡大津町高尾野272-4
Tel: 096-292-1600
Fax: 096-292-1610

合志事業所

〒861-1116 熊本県菊池郡合志町福原1-1
Tel: 096-349-5500
Fax: 096-349-5528

東京エレクトロン宮城株式会社

〒981-0203 宮城県宮城郡松島町根廻字猫追1-1
Tel: 022-355-1500
Fax: 022-355-1501

東京エレクトロンEE株式会社

〒220-0101 神奈川県津久井郡城山町町屋1-2-41
Tel: 042-783-1331
Fax: 042-783-1525

東京エレクトロン札幌株式会社

〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西1丁目
丸増ビルNo.18
Tel: 011-700-2211
Fax: 011-700-2800

東京エレクトロンFE株式会社

〒183-8705 東京都府中市住吉町2-30-7
Tel: 042-333-8411
Fax: 042-333-8495

フィールド・エンジニアリング・ステーション

大阪 熊本 岩手 鶴岡 仙台 会津若松
高崎 水戸 蕨崎 富山 桑名 福山
東広島 西条 大分 長崎 菊陽 鹿児島

東京エレクトロン デバイス株式会社

〒224-0045 神奈川県横浜市都筑区東方町1
Tel: 045-474-7000
Fax: 045-474-7092

営業所

宇都宮 水戸 熊谷 神田 立川 山梨 松本
名古屋 大阪 福岡

東京エレクトロン リース株式会社

〒183-8705 東京都府中市住吉町2-30-7
Tel: 042-333-8337
Fax: 042-333-8488

東京エレクトロン ロジスティクス株式会社

〒183-8705 東京都府中市住吉町2-30-7
Tel: 042-333-8100
Fax: 042-333-8494

東京エレクトロン エージェンシー株式会社

〒183-8705 東京都府中市住吉町2-30-7
Tel: 042-333-8300
Fax: 042-333-8499



Tokyo Electron Europe Limited
Crawley Office



東京エレクトロン株式会社
本社 TBS放送センター15F - 18F)



Tokyo Electron Taiwan Limited



Tokyo Electron Korea Limited
Pundang Office

アメリカ

TOKYO ELECTRON AMERICA, INC.

Austin Office

2400 Grove Boulevard
Austin, Texas 78741
Tel: 512-424-1000

Branch Offices

Albuquerque Office, Boise Office, Burlington Office,
Dallas Office, Fishkill Office, Eugene Office,
Los Angeles Office, Manassas Office, Orlando Office,
Phoenix Office, Portland Office, Richmond Office,
Roseville Office, Santa Clara Office, South Portland
Office

TOKYO ELECTRON OREGON, INC.

5350 N.E. Dawson Creek Drive
Hillsboro, Oregon 97124
Tel: 503-615-2100

TOKYO ELECTRON TEXAS, INC.

2500 Montopolis Drive
Austin, Texas 78741
Tel: 512-486-4000

TOKYO ELECTRON MASSACHUSETTS, INC.

123 Brimbal Avenue
Beverly, Massachusetts 01915
Tel: 978-921-0031

Branch Office

Santa Clara Office, Portland Office

TOKYO ELECTRON PHOENIX LABORATORIES, INC.

1829 W. Drake Drive, Suite 103
Tempe, Arizona 85283
Tel: 480-345-6470

TOKYO ELECTRON ARIZONA, INC.

2120 West Guadalupe Road
Gilbert, Arizona 85233
Tel: 480-507-8100

ヨーロッパ

TOKYO ELECTRON EUROPE LIMITED

Crawley Office

Premiere House
Betts Way, London Road
Crawley, West Sussex, RH10 2GB England
Tel: 1293-655800

Branch Offices

European Distribution Centre, Livingston Office

TOKYO ELECTRON ITALIA S.p.A.

Milan Office

Centro Direzionale Colleoni
Via Paracelso 26
20041 Agrate Brianza, Milan, Italy
Tel: 039-656081

Branch Offices

Avezzano Office, Catania Office

TOKYO ELECTRON DEUTSCHLAND GmbH

Munich Office

Office-Center-Ismaning
Carl-Zeiss-Ring 5
85737, Ismaning, Germany
Tel: 89-96278-0

Branch Office

Dresden Office

TOKYO ELECTRON SWITZERLAND LIMITED

Chemin de Buchaux 38
CH-2022, Bevaix, Switzerland
Tel: 32-846-20-60

TOKYO ELECTRON NEDERLAND B.V.

Kerkenbos 10-15, Unit C
6546 BB Nijmegen,
The Netherlands
Tel: 243-726630

TOKYO ELECTRON FRANCE S.A.R.L.

1, Chemin de la Dhuy
Batiment Alicante
38240 Meylan, France
Tel: 4760-41244

TOKYO ELECTRON ISRAEL LIMITED

S Habarzel St.
Gat 2000 Industrial Zone
Kiryat Gat, Israel
Tel: 7-681-0860

TOKYO ELECTRON ESPAÑA S.L.

TOKYO ELECTRON IRELAND LIMITED

c/o Intel Ir5 Mfg.
Collinstown Industrial Park
Leixlip, Co. Kildare, Ireland
Tel: 1-606-7923

アジア

TOKYO ELECTRON KOREA LIMITED

Pundang Office

325-230, Dongchun-ri
Suji-up, Yongin-city
Kyonggi-do, 449-840 Korea
Tel: 31-260-5000

Branch Offices

Cheongju Office, Gumi Office, Icheon Office,
Kiheung Office, Pucheon Office

TOKYO ELECTRON TAIWAN LIMITED

2F1, No. 346, Pei Da Road
Hsin-chu, Taiwan, R.O.C.
Tel: 3-525-3400

TOKYO ELECTRON LIMITED

SHANGHAI REPRESENTATIVE OFFICE

Suite 1004
777 Zhao Jia Bang Road
Shanghai 200032, China
Tel: 21-6443-8067



Tokyo Electron Oregon, Inc.



Tokyo Electron Massachusetts, Inc.



Tokyo Electron Arizona, Inc.



Tokyo Electron America, Inc.
Austin Office



Tokyo Electron Texas, Inc.

株主メモ

(2000年3月31日現在)

社名 東京エレクトロン株式会社

設立 1963年11月11日

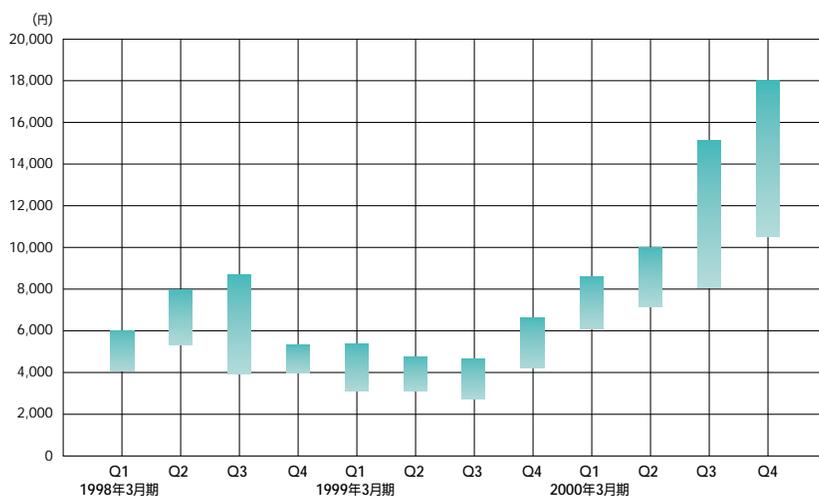
株式 額面普通株式1株の金額 50円
授權株式数 300,000,000株
発行済株式総数 175,659,848株

株主数 7,147名

株主名義書換代理人 中央三井信託銀行株式会社
〒104-8345 東京都中央区京橋一丁目7番1号

上場証券取引所 東京証券取引所市場第一部 (#8035)

株価推移



お問い合わせ先 東京エレクトロン株式会社
経営戦略室 IRグループ
〒107-8481 東京都港区赤坂五丁目3番6号
Tel: 03-5561-7003
Fax: 03-5561-7365
E-mail: ir@corp.tel.co.jp



東京エレクトロン株式会社

〒107-8481 東京都港区赤坂5-3-6 TBS放送センター
Tel: 03-5561-7000 Fax: 03-5561-7400
URL: <http://www.tel.co.jp/>